

Низкотемпературный отжиг слаболегированных слоев n-4H-SiC после облучения быстрыми электронами
Korolkov, Oleg; Kozlovski, Vitali; Lebedev, Alexander; **Sleptšuk, Natalja**; Toompuu, Jana; Rang, Toomas Физика и техника
полупроводников 2019 / с. 991-994 <https://doi.org/10.21883/FTP.2019.07.47879.9089>